

(19) Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) EP 0 977 281 A1

## (12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
02.02.2000 Patentblatt 2000/05

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>: H01L 39/14

(21) Anmeldenummer: 99114555.8

(22) Anmelddatum: 24.07.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 28.07.1998 DE 19833918

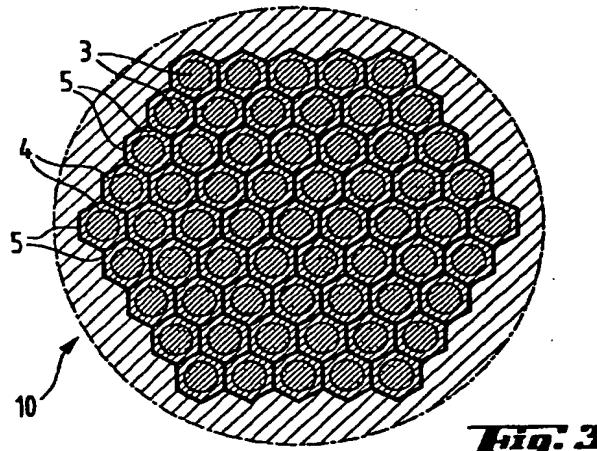
(71) Anmelder:  
Aventis Research & Technologies GmbH & Co.  
KG  
65926 Frankfurt am Main (DE)

(72) Erfinder:  

- Bock, Joachim Dr.  
50374 Erftstadt (DE)
- Bäcker, Michael Dr.  
50677 Köln (DE)
- Fischer, Bernhard Dr.  
91058 Erlangen (DE)
- Müller, Jens  
91058 Erlangen (DE)
- Kautz, Stefan  
90607 Rückersdorf (DE)

## (54) Hoch-Tc-Wechselstrommehrkerndsupraleiter sowie Verfahren zu dessen Herstellung

(57) Der Wechselstrom-Supraleiter enthält mehrere Leiterkerne (3) aus Hoch-T<sub>c</sub>-Supraleitermaterial eines Bi-Cuprates, die von Ag-Matrixmaterial (4) umschlossen sind. Jeder Leiterkern soll außerdem von einer widerstandserhöhenden Umhüllung (5) aus einem Material auf Basis eines nicht-supraleitenden Bi-Sr-Cuprates oder Sr-Ca-Cuprates umgeben sein. Das Umhüllungsmaterial soll dabei auf zu bündelnde Leiterelemente (2), die zum Aufbau des Supraleiters dienen, in Form einer Schmelze aufgebracht werden.



**Fig. 3**

BEST AVAILABLE COPY

EP 0 977 281 A1

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Wechselstrom-Supraleiter mit mehreren Leiterkernen, welche jeweils

- ein Supraleitermaterial mit einer metalloxidischen Hoch- $T_c$ -Phase auf Basis eines Bi-Cuprates aufweisen,
- in ein Ag zumindest enthaltendes Matrixmaterial eingebettet sind und
- von einer Umhüllung umgeben sind, die aus einem metalloxidischen Material mit einem gegenüber dem Matrixmaterial vergleichsweise größeren spezifischen elektrischen Widerstand bestehen.

[0002] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Mehrkernsupraleiters. Ein entsprechender Mehrkernsupraleiter mit diesen Merkmalen sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung gehen aus der WO96/28853 hervor.

[0003] Es sind supraleitende Metalloxidverbindungen mit hohen Sprungtemperaturen  $T_c$  von über 77 K bekannt, die deshalb auch als Hoch- $T_c$ -Supraleitermaterialien oder HTS-Materialien bezeichnet werden und insbesondere eine LN<sub>2</sub>-Kühletechnik erlauben. Unter solche Metalloxidverbindungen fallen insbesondere Cuprate des speziellen Stoffsystems vom Grundtyp Bi-Sr-Ca-Cu-O. Innerhalb dieses Stoffsystems treten mehrere supraleitende Hoch- $T_c$ -Phasen auf, die sich durch die Anzahl ihrer Kupfer-Sauerstoff-Netzebenen bzw. -Schichten innerhalb der kristallinen Einheitszelle unterscheiden und die verschiedene Sprungtemperaturen  $T_c$  aufweisen. So sind eine Phase mit einer Sprungtemperatur von etwa 80 K der Zusammensetzung Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>CaCu<sub>2</sub>O<sub>y</sub> (80 K-Phase, 2-Schichter oder 2212-Phase) und eine Phase mit einer Sprungtemperatur von etwa 110 K der Zusammensetzung Bi<sub>2</sub>Sr<sub>2</sub>Ca<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>x</sub> (110 K-Phase, 3-Schichter oder 2223-Phase) bekannt. Insbesondere bei letzterer Phase kann die Bi-Komponente durch Pb partiell substituiert sein.

[0004] Mit diesen HTS-Materialien wird versucht, langgestreckte Supraleiter in Draht- oder Bandform herzustellen. Ein hierfür als geeignet angesehener Verfahrensschritt ist die sogenannte „Pulver-im-Rohr-Technik“, die prinzipiell von der Herstellung von Supraleitern mit dem klassischen metallischen Supraleitermaterial Nb<sub>3</sub>Sn her bekannt ist. Entsprechend dieser Technik wird auch zur Herstellung von Leitern aus dem genannten HTS-Material in eine rohrförmige Hülle bzw. in eine Matrix aus einem normalleitenden Material, insbesondere aus Ag oder einem Ag-haltigen Material, Pulver aus einem Vormaterial (sogenanntes „Precursor“-Material) eingebracht, das im allgemeinen noch nicht oder nur zu einem geringen Teil die gewünschte supraleitende Hoch- $T_c$ -Phase enthält. Der so zu erhaltende Aufbau wird anschließend mittels einer mehrere Verformungsschritte einschließenden Verformungsbe-

handlung, die gegebenenfalls durch mindestens einen Wärmebehandlungsschritt bei erhöhter Temperatur unterbrochen sein können, auf die gewünschte Enddimension gebracht. Danach wird das so erhaltene Leiterzwischenprodukt zur Einstellung oder Optimierung seiner supraleitenden Eigenschaften bzw. zur Ausbildung der gewünschten Hoch- $T_c$ -Phase noch mindestens einem Glühschritt unterzogen. Dieser Glühschritt wird wenigstens teilweise in

5 einer sauerstoffhaltigen Atmosphäre bei erhöhter Temperatur durchgeführt, die im Falle des Stoffsystems (Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O bei Glühung an Luft im allgemeinen zwischen 835° C und 840° C und bei reduziertem Sauerstoffpartialdruck bei etwa 815° C liegt (vgl. z.B. auch „Supercond. Sci. Technol.“, Vol. 4, 1991, Seiten 165 bis 171).

[0005] Bündelt man in an sich bekannter Weise mehrere entsprechenden Hoch- $T_c$ -Supraleiter oder Vorformen dieser Leiter, so kann man auch ein Endprodukt 10 mit mehreren supraleitenden Leiterkernen, einen sogenannten Mehrkern- oder Multifilamentleiter, erhalten (vgl. auch „IEEE Transactions on Applied Superconductivity“, Vol. 5, No. 2, Juni 1995, Seiten 1145 bis 1149 oder 1259 bis 1261). Insbesondere für Wechselstrom(AC)-Anwendungen kann das Bündel von einzelnen Leiterkernen um die gemeinsame Leiterachse verdrillt (getwistet) werden.

[0006] Es zeigt sich jedoch, daß entsprechende Mehrkernleiter bei AC-Anwendungen über die elektrisch gut leitende Matrix verhältnismäßig große AC-Verluste erzeugen, die zu einer Beeinträchtigung der supraleitenden Eigenschaften des Leiters führen können. Gemäß der eingangs genannten WO-Schrift wird deshalb eine elektrisch schlecht-leitende oder isolierende Umhüllung bzw. Barriere um jeden einzelnen Leiterkern vorgesehen. Als Materialien sollen dabei Oxide von metallischen Elementen wie z.B. Cu oder Al oder Zr eingesetzt werden. Auch Gemische aus mehreren dieser Oxiden werden als geeignet betrachtet. Die entsprechenden Umhüllungen werden durch Verwendung von oxidischen Materialien von vornherein realisiert oder durch nachträgliche Oxidation der entsprechenden metallischen Elemente ausgebildet.

[0007] Derartige Umhüllungen oder Barrieren in AC-Mehrkernsupraleitern der eingangs genannten Art müssen neben dem Erfordernis einer geringen elektrischen Leitfähigkeit unter anderem auch die Forderung erfüllen, daß sie keine Diffusionsbarrieren für einen Sauerstofftransport durch die Matrix darstellen, der für die Bildung der gewünschten supraleitenden Hoch- $T_c$ -Phase des Bi-Cuprates notwendig ist. Darüber hinaus dürfen sie keine unerwünschten Reaktionen mit den Komponenten des HTS-Materials eingehen, die zu einer Beeinträchtigung der supraleitenden Eigenschaften führen könnten. Auch sollen sie bei Verformungsprozessen ihr Umformverhalten praktisch nicht ändern.

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Material für solche Umhüllungen anzugeben, mit dem

die genannten Forderungen zu erfüllen sind. Außerdem soll ein Verfahren zur Herstellung eines Mehrkernsupraleiters und insbesondere zur Ausbildung einer solchen Umhüllung angegeben werden.

[0009] Diese Aufgabe wird bezüglich des Mehrkernsupraleiters mit den eingangs genannten Merkmalen dadurch gelöst, daß als Material der Umhüllung ein  $\text{Bi}_{1,8-2,2}\text{Sr}_{1,8-2,2}\text{Cu}_{0,8-1,2}\text{O}_x$  oder  $(\text{Sr}_\alpha\text{Ca}_{1-\alpha})\text{Cu}_y\text{O}_z$  (mit  $0,1 \leq \alpha \leq 0,9$  und  $0,3 \leq y \leq 3$ ) zumindest enthaltendes, nicht-supraleitendes Cupratmaterial vorgesehen ist. Die nicht-supraleitenden Cuprate stellen jeweils nur einen Grundtyp dar, der eine an sich bekannte teilweise Substitution einzelner Komponenten dieser Materialien sowie Abweichungen von der exakten Stöchiometrie mit einschließen soll. Die Sauerstoffindizes sind allgemein bekannt.

[0010] Die mit dieser Ausgestaltung des Mehrkernsupraleiters verbundenen Vorteile sind darin zu sehen, daß bei Verwendung von Umhüllungen aus den genannten Materialien einerseits keine Beeinträchtigung des Supraleitermaterials und des Sauerstofftransports zu beobachten ist und daß andererseits bei einer gemeinsamen Verformung von mehreren entsprechend umhüllten Leiterkernen das Umformverhalten der Umhüllungen und des gesamten Leiteraufbaus praktisch unverändert bleibt.

[0011] Diese Eigenschaften der Umhüllungsmaterialien kommen insbesondere bei Mehrkernsupraleitern zu tragen, die zumindest zu einem überwiegenden Anteil, d.h. zu mehr als 80 Gew.-%, vorzugsweise zu mehr als 90 Gew.-%, die 2223-Phase aufweisen sollen.

[0012] Darüber hinaus sind die genannten Eigenschaften des erfindungsgemäßen Umhüllungsmaterials, insbesondere die gute Umformungseigenschaft, von Vorteil, wenn der Mehrkernsupraleiter eine Bandform aufweisen soll.

[0013] Ein Verfahren zur Herstellung des Mehrkernsupraleiters nach der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß Leiterelemente mit jeweils einem von dem Matrixmaterial umgebenen Kern aus einem Vormaterial des Supraleitermaterials ausgebildet werden, die einem das Vormaterial verdichtenden Verformungsprozeß und gegebenenfalls einer Glühbehandlung unterzogen werden, daß dann diese Leiterelemente jeweils mit einem Überzug aus dem Material der Umhüllung versehen werden, und daß anschließend mit einem Bündel aus umhüllten Leiterelementen ein Mehrkernrohleiter gebildet wird, der mittels einer Verformungs- und Glühbehandlung in ein Leiterendprodukt überführt wird. Dabei können vorteilhaft die Leiterelemente durch ein Bad einer Schmelze des Umhüllungsmaterials gezogen werden. Die Schmelztemperatur des Umhüllungsmaterials kann nämlich deutlich unter der Glühtemperatur (Sintertemperatur) zur Ausbildung der gewünschten Hoch-T<sub>c</sub>-Phase gehalten werden, so daß dann eine Änderung der Phasenzusammensetzung nicht zu befürchten ist.

[0014] Statt des gewünschten, endgültigen Umhüllungsmaterials kann für das Bad der Schmelze auch ein Materialvorprodukt vorgesehen werden, das während des Ziehens oder nach dem Ziehen der Leiterelemente durch die Schmelze einer Oxidationsbehandlung unterzogen wird, um so das endgültige, oxidische Umhüllungsmaterial auszubilden.

[0015] Gemäß einer weiteren Verfahrensvariante werden zum Überziehen der Leiterelemente diese durch eine ein feinpulviges Umhüllungsmaterial oder ein Materialvorprodukt desselben enthaltende Suspension gezogen und wird das anhaftende Pulver anschließend in einer Heizzone aufgeschmolzen. Auch hier ist es möglich, das Materialvorprodukt vor dem Aufschmelzen in der Heizzone oder während des Aufschmelzens einer Oxidationsbehandlung zu unterziehen. Auch mit dieser weiteren Verfahrensvariante ist ein vorteilhaft einfacher durchzuführendes Umhüllen der Leiterelemente möglich.

[0016] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Mehrkernsupraleiters bzw. des Verfahrens zu seiner Herstellung gehen aus den jeweils abhängigen Ansprüchen hervor.

[0017] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels noch weiter erläutert. Dabei wird auf die Zeichnung Bezug genommen,

- deren Figuren 1 und 2 je ein Leiterelement zum Aufbau eines erfindungsgemäßen Mehrkernsupraleiters und
- deren Figur 3 einen mit mehreren solchen Leiterelementen aufgebauten Mehrkernrohleiter als Zwischenprodukt bei der Herstellung des Mehrkernsupraleiters jeweils schematisch im Querschnitt zeigen. Dabei sind in den Figuren sich entsprechende Teile mit denselben Bezugszeichen versehen.

[0018] Figur 1 zeigt ein entsprechendes, allgemein mit 2 bezeichnetes Leiterelement. Sein zentraler Kern 3 besteht aus dem HTS-Vormaterial und ist von einer Ag-Hülle 4 umschlossen. Dieser Aufbau ist noch mit einer erfindungsgemäßen Umhüllung 5 versehen. Als Material dieser Umhüllung kommen nicht-supraleitende Cuprate auf Basis von  $\text{Bi}_{1,8-2,2}\text{Sr}_{1,8-2,2}\text{Cu}_{0,8-1,2}\text{O}_x$  oder  $(\text{Sr}_\alpha\text{Ca}_{1-\alpha})\text{Cu}_y\text{O}_z$  (mit  $0,1 \leq \alpha \leq 0,9$  und  $0,3 \leq y \leq 3$  in Frage. Diese Materialien stellen jeweils nur einen Grundtyp dar: D.h., einzelne ihrer Komponenten können in an sich bekannter Weise durch weitere Komponenten partiell substituiert sein. Für die Substitution kommen insbesondere andere Erdalkalimaterialien, insbesondere Ca, oder auch Pb oder Sb in Frage. So ist es z.B. bei einer beabsichtigten Ausbildung einer Hoch-T<sub>c</sub>-Phase des Supraleitermaterials der Zusammensetzung  $(\text{Bi},\text{Pb})_2\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_x$  besonders vorteilhaft, wenn auch im Bi-Cuprat-Umhüllungsmaterial die Bi-Komponente in entsprechender Weise durch Pb partiell substituiert ist. Der Anteil an Pb in dem Material liegt dabei im allgemeinen zwischen 10 und 40 Gew.-%.

Außerdem kann die Sr-Komponente bis zu 20 Gew.-% durch Ba substituiert werden.

[0019] Die Basis-Verbindung  $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_x$  des Umhüllungsmaterials kann desweiteren in einem weiten Zusammensetzungsbereich variieren, ohne daß sich der Verbindungstyp praktisch ändert. Dieser Zusammensetzungsbereich umfaßt ungefähr  $\text{Bi}_{1,8-2,2}\text{Sr}_{1,8-2,2}\text{Cu}_{0,8-1,2}\text{O}_x$ .

[0020] Auch im Fall des Umhüllungsmaterials mit oder aus der Basis-Verbindung  $(\text{Sr}, \text{Ca}_{1-\alpha})\text{Cu}_y\text{O}_z$  ist eine entsprechende Variation des Zusammensetzungsbereichs möglich. Dieser Zusammensetzungsbereich ist ungefähr durch  $0,1 \leq \alpha \leq 0,9$  und  $0,3 \leq y \leq 3$  festgelegt. Als besonders vorteilhaft sind dabei folgende Zusammensetzungen anzusehen:  $(\text{Sr}, \text{Ca})\text{CuO}_2$  wie z.B. das  $\text{SrCaCu}_2\text{O}_z$  mit  $z \approx 3$  oder  $(\text{Sr}, \text{Ca})_2\text{CuO}_2$  oder  $(\text{Sr}, \text{Ca})_{14}\text{Cu}_{24}\text{O}_{2z}$ . Auch hierbei kann beispielsweise die Sr-Komponente bis zu 20 Gew.-% durch Ba substituiert werden. Der z-Index kann bei den einzelnen Cupraten verschieden sein.

Die genannten Umhüllungsmaterialien können mit an sich bekannten physikalischen oder chemischen Abscheidungsprozessen aufgebracht bzw. abgeschieden werden. Als ein besonders einfach auszuführendes Verfahren wird vorteilhaft eine Schmelze aus dem gewählten Umhüllungsmaterial in entsprechender Zusammensetzung vorgesehen, durch die der noch nicht umhüllte Teil des Leiterelementes 2 gezogen wird. Die Schmelze braucht nicht unbedingt aus dem fertigen, oxidischen Umhüllungsmaterial zu bestehen. Vielmehr kann sie auch aus einem Materialvorprodukt des gewünschten Umhüllungsmaterials gebildet werden. Dieses Materialvorprodukt läßt sich dann während des Ziehens der Leiterelemente durch die entsprechende Schmelze oder nach dem Ziehen durch diese Schmelze in das gewünschte Umhüllungsmaterial mittels einer Oxidationsbehandlung überführen.

[0021] Eine weitere einfache Beschichtungsmöglichkeit besteht darin, jedes nicht-umhüllte Leiterelement durch eine feinteilige Suspension aus dem Umhüllungsmaterial oder aus Metalloxiden entsprechend der gewünschten Zusammensetzung des Umhüllungsmaterials zu ziehen. Das anhaftende Oxidpulver wird danach direkt auf dem jeweiligen Leiterelement in einer kurzen Heizzone geschmolzen und bildet so eine besonders dünne und homogene Schmelzumhüllung des Leiterelementes aus. Statt des Umhüllungsmaterials oder den entsprechenden Metalloxiden ist auch ein Materialvorprodukt verwendbar, das vor dem Aufschmelzen in der Heizzone oder während des Aufschmelzens einer Oxidationsbehandlung unterzogen wird, um so das gewünschte oxidische Material zu erhalten.

[0022] Die Schmelztemperatur der Verbindung mit der stöchiometrischen Zusammensetzung  $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_x$  beträgt etwa 840°C. Durch eine teilweise Substitution von Bi durch Pb und eine Erhöhung des Bi-Anteils gegenüber Sr und Cu läßt sich der Schmelzpunkt des

Umhüllungsmaterials bis auf etwa 750°C erniedrigen. Da die Ausbildung der Hoch-T<sub>c</sub>-Phase im Leiterelement bei vergleichsweise höheren Temperaturen erfolgt, ist hier keine Beeinträchtigung durch den Beschichtungsprozeß zu befürchten.

[0023] Eine weitere Reduzierung des Schmelzpunktes kann z.B. durch eine Zumischung von bis zu 50 Gew.-% Bi- und Pb-Oxid erreicht werden. Diese Oxide dienen dann als Flußmittel und werden nicht in die Basis-Verbindung  $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_x$  eingebaut. Der Gehalt an Fremdphasen im Umhüllungsmaterial gegenüber  $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_x$  kann bis zu 50 Gew.-% betragen.

[0024] Das in Figur 2 gezeigte Leiterelement 7 unterscheidet sich von dem Leiterelement 2 nach Figur 1 lediglich dadurch, daß statt eines kreisförmigen Querschnittes ein polygonaler Querschnitt mit Sechseckform vorgesehen ist. Mit entsprechend geformten Leiterelementen ist eine Bündelung mit besonders hoher Packungsdichte möglich.

[0025] Abweichend von den in den Figuren 1 und 2 dargestellten Ausführungsformen eines Leiterelementes 2 bzw. 7 ist auch ein Aufbau möglich, bei dem die Umhüllung 5 noch mit mindestens einer weiteren Schicht, z.B. aus dem Material der normalleitenden Ag-Hülle, umschlossen ist (vgl. die genannte WO-Schrift).

[0026] Um zu einem Mehrkernleiter zu gelangen, wird in bekannter Weise eine Bündelung von mehreren solcher Leiterelementen in einem größeren (zweiten) Hüllrohr insbesondere aus dem Matrixmaterial vorgenommen. Der so gewonnene Aufbau kann anschließend noch weiter kompaktiert und gegebenenfalls geglättet werden, bevor er in an sich bekannter Weise mittels einer weiteren Verformungs- und Glühbehandlung in das angestrebte Endprodukt überführt wird.

[0027] Diese weitere Verformungs- und Glühbehandlung umfaßt dabei eine Reihe von einzelnen Schritten. Der vor diesen Schritten vorliegende Mehrkernaufbau sei nachfolgend als Mehrkernrohleiter bezeichnet. Eine entsprechende Ausführungsform eines solchen Mehrkernrohleiters ist in Figur 3 teilweise angedeutet und mit 10 bezeichnet. Der Rohleiter hat im allgemeinen einen kreisförmigen Querschnitt. Falls eine Bandform des Leiterendproduktes angestrebt ist, muß der Rohleiter einem Flachbearbeitungsprozeß mit mehreren Walzschritten und einer Wärme- und Glühbehandlung unterzogen werden, die wenigstens einen, im allgemeinen am Ende des Flachbearbeitungsprozesses vorzugsweise in einer sauerstoffhaltigen Atmosphäre wie z.B. an Luft durchzuführenden (Abschluß-)Glühschritt umfaßt. Auf diese Weise ist dem Vorproduktmaterial der für die Ausbildung der gewünschten supraleitenden Phase erforderliche Sauerstoff zur Verfügung zu stellen und/oder kann die Wiederherstellung dieser Phase gewährleistet werden, ohne daß durch die Verwendung der erfindungsgemäßen, schlecht- oder nicht-leitenden Umhüllungen 5 ein Sauerstofftransport behindert würde. In der Figur 3 sind diese Umhüllungen durch verstärkte Linien angedeutet.

[0027] Gemäß den vorstehend dargestellten Ausführungsbeispielen wurde davon ausgegangen, daß die Umhüllung 5 im allgemeinen zu 100 % aus einem der genannten oxidischen Materialien besteht. Selbstverständlich sind auch Ausführungsformen geeignet, die das gewünschte oxidische Material nur überwiegend, d.h. zu mehr als 50 Gew.-% enthalten. Der restliche Gehalt wird dann im allgemeinen von Fremdphasen, die nicht unbedingt Oxide sein müssen, eingenommen.

#### Patentansprüche

1. Wechselstrom-Supraleiter mit mehreren Leiterkernen, welche jeweils

- ein Supraleitermaterial mit einer metalloxidischen Hoch-T<sub>c</sub>-Phase auf Basis eines Bi-Cuprates aufweisen,
- in ein Ag zumindest enthaltendes Matrixmaterial eingebettet sind und
- von einer Umhüllung umgeben sind, die aus einem metalloxidischen Material mit einem gegenüber dem Matrixmaterial vergleichsweise größeren spezifischen elektrischen Widerstand bestehen,  
dadurch gekennzeichnet, daß als Material der Umhüllung (5) ein Bi<sub>1,8-2,2</sub>Sr<sub>1,8-2,2</sub>Cu<sub>0,8-1,2</sub>O<sub>x</sub> zumindest enthaltendes, nicht-supraleitendes Bi-Sr-Cuprat vorgesehen ist.

2. Wechselstrom-Supraleiter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Material der Umhüllung (5) einen Anteil an dem nicht-supraleitenden Bi-Sr-Cupratmaterial von mindestens 50 Gew.-% aufweist.

3. Wechselstrom-Supraleiter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Bi-Komponente des supraleitenden Bi-Cuprates und/oder des nicht-supraleitenden Bi-Sr-Cupratmaterials der Umhüllung (5) partiell durch Pb substituiert ist.

4. Wechselstrom-Supraleiter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß 10 bis 40 Gew.-% der Bi-Komponente durch Pb substituiert sind.

5. Wechselstrom-Supraleiter mit mehreren Leiterkernen, welche jeweils

- ein Supraleitermaterial mit einer metalloxidischen Hoch-T<sub>c</sub>-Phase auf Basis eines Bi-Cuprates aufweisen,
- in ein Ag zumindest enthaltendes Matrixmaterial eingebettet sind, und
- von einer Umhüllung umgeben sind, die aus einem metalloxidischen Material mit einem gegenüber dem Matrixmaterial vergleichsweise größeren spezifischen elektrischen

5

10

15

20

30

35

40

45

50

55

Widerstand bestehen,  
dadurch gekennzeichnet, daß als Material der Umhüllung (5) ein (Sr<sub>α</sub>Ca<sub>1-α</sub>)Cu<sub>y</sub>O<sub>z</sub> zumindest enthaltendes, nicht-supraleitendes Sr-Ca-Cupratmaterial vorgesehen ist, wobei gilt:

$$0,1 \leq \alpha \leq 0,9 \text{ und } 0,3 \leq y \leq 3.$$

6. Wechselstrom-Supraleiter nach Anspruch 5, gekennzeichnet durch ein Material der Umhüllung aus der Gruppe (Sr, Ca)CuO<sub>z</sub>, (Sr, Ca)<sub>2</sub>CuO<sub>z</sub>, (Sr, Ca)<sub>14</sub>Cu<sub>24</sub>O<sub>z</sub>, SrCaCu<sub>2</sub>O<sub>z</sub>.

7. Wechselstrom-Supraleiter nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Material der Umhüllung (5) einen Anteil an dem nicht-supraleitenden Sr-Ca-Cupratmaterial von mindestens 50 Gew.-% aufweist.

8. Wechselstrom-Supraleiter nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Sr-Komponente des Umhüllungsmaterials bis zu 20 Gew.-% durch Ba substituiert ist.

9. Wechselstrom-Supraleiter nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Supraleitermaterial die 2223-Phase des Bi-Cuprates zumindest zu einem überwiegenden Anteil aufweist.

10. Wechselstrom-Supraleiter nach einem der Ansprüche 1 bis 9, gekennzeichnet durch eine Bandform.

11. Verfahren zur Herstellung eines Wechselstrom-Supraleiters nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß Leiterelemente (2, 7) mit jeweils einem von dem Matrixmaterial (4) umgebenen Kern (3) aus einem Vormaterial des Supraleitermaterials ausgebildet werden, die einem das Vormaterial verdichtenden Verformungsprozeß und gegebenenfalls einer Glühbehandlung unterzogen werden, daß die Leiterelemente (2, 7) jeweils mit einem Überzug (5) aus dem Material der Umhüllung versehen werden, mit einem Bündel aus umhüllten Leiterelementen ein Mehrkernrohleiter (10) gebildet wird, der mittels einer anschließenden Verformungs- und Glühbehandlung in ein Leiterendprodukt überführt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß zum Überziehen der Leiterelemente (2, 7) diese durch ein Bad einer Schmelze aus dem Umhüllungsmaterial oder einem Materialvorprodukt desselben gezogen werden.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Materialvorprodukt während des Ziehens oder nach dem Ziehen der Leiterelemente

(2, 7) durch die Schmelze einer Oxidationsbehandlung unterzogen wird.

14. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß zum Überziehen der Leiterelemente (2, 7) diese durch eine ein feinpulvriges Umhüllungsmaterial oder ein Materialvorprodukt desselben enthaltende Suspension gezogen werden und daß das anhaftende Pulver anschließend in einer Heizzone aufgeschmolzen wird. 5
15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß das Materialvorprodukt vor dem Aufschmelzen in der Heizzone oder während des Aufschmelzens einer Oxidationsbehandlung unterzogen wird. 15
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Leiterelemente (2, 7) nach einer Pulver-im-Rohr-Technik erstellt werden. 20

25

30

35

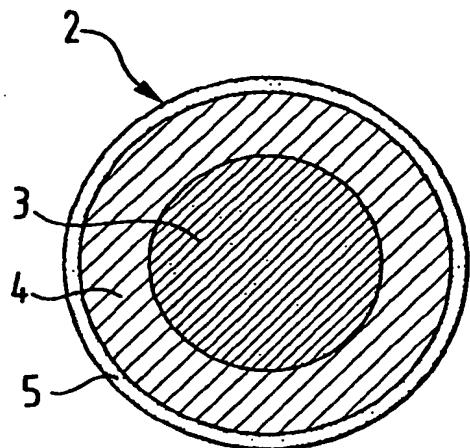
40

45

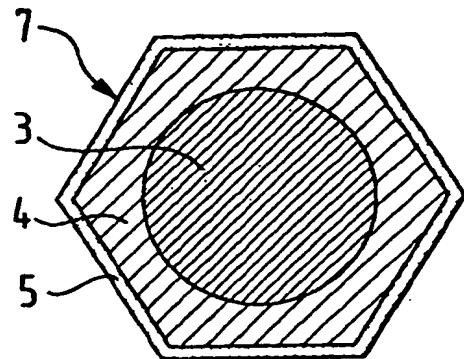
50

55

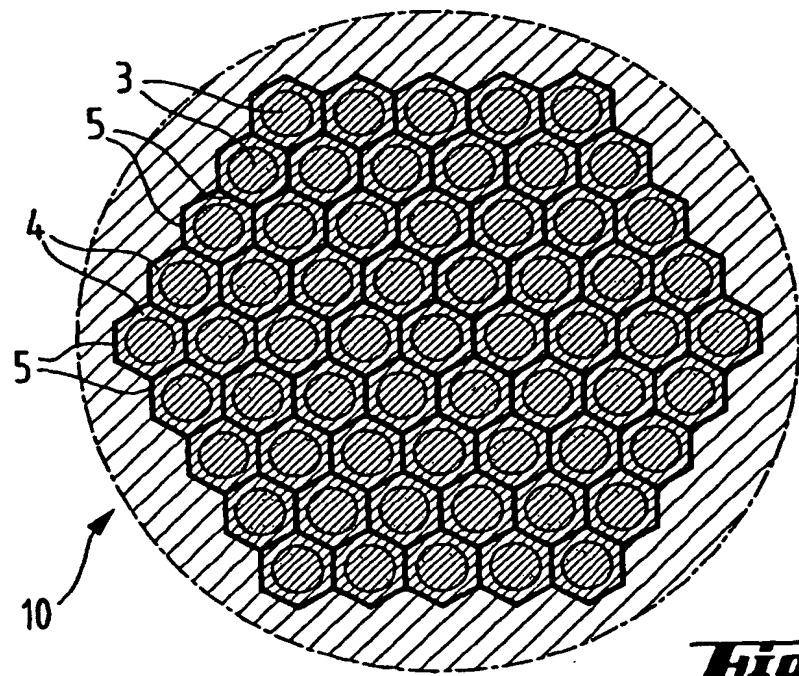
6



***Fig. 1***



***Fig. 2***



***Fig. 3***



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 99 11 4555

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE									
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betreff Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl7)						
P, X	EP 0 867 950 A (ALSTHOM CGE ALCATEL) 30. September 1998 (1998-09-30) * Spalte 2, Zeile 8-28 *	1	H01L39/14						
A	WO 98 13859 A (AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP) 2. April 1998 (1998-04-02) * Ansprüche 1,6 *	1							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int.Cl7)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">H01L</td> </tr> </table>				RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int.Cl7)		H01L			
RECHERCHIERTE SACHGEBiete (Int.Cl7)									
H01L									
<p>Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt</p> <table border="1"> <tr> <td>Recherchenort</td> <td>Abschlußdatum der Recherche</td> <td>Prüfer</td> </tr> <tr> <td>DEN HAAG</td> <td>9. November 1999</td> <td>Pelsers, L</td> </tr> </table> <p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet  Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie  A : technologischer Hintergrund  O : nichtschriftliche Offenbarung  P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze  E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist  D : in der Anmeldung angeführtes Dokument  L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument  &amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>				Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	DEN HAAG	9. November 1999	Pelsers, L
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer							
DEN HAAG	9. November 1999	Pelsers, L							